

強誘電体メモリ FRAM

FRAMは、書き換え速度が速い、書き換え回数が多いという特長を持つ不揮発性RAMで、次世代メモリの筆頭です。

富士通は1999年の量産開始以来FRAMのリーディングカンパニーとして市場を牽引しています。

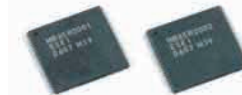
特長

- 高速書き込み (write cycle = read cycle)
- 低消費電力動作 (内部昇圧不要)
- 100億回以上の書き込み/読み出し耐性

富士通FRAMと従来メモリとの比較

	富士通 FRAM	E ² PROM	SRAM
メモリタイプ	不揮発性	不揮発性	揮発性
セル方式	1T1C/2T2C	2T	6T
書き換え方法	重ね書き	消去+書き込み	重ね書き
ライトサイクルタイム	150ns	5ms	55ns
書き換え回数	100億回	100万回	無制限

新製品 2MビットFRAM を量産開始!



1Mビット製品と同一パッケージで大容量化を実現しました。

